

[Previous Doc](#) [Next Doc](#) [Go to Doc#](#)
[First Hit](#)

C

[Generate Collection](#)

L4: Entry 11 of 13

File: JPAB

Mar 8, 1984

PUB-N0: JP359041835A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59041835 A
TITLE: EXFOLIATING METHOD OF RESIST

PUBN-DATE: March 8, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
MARUYAMA, HIROSHI	

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
FUJITSU LTD	

APPL-NO: JP57151526

APPL-DATE: August 31, 1982

US-CL-CURRENT: 430/329

INT-CL (IPC): H01L 21/30

ABSTRACT:

PURPOSE: To shorten plasma-ashing time by preparatorily heating a substrate to be treated with a resist film to be exfoliated, arranging the substrate in a plasma-ashing device and incinerating and removing the resist film by oxygen plasma while being heated.

CONSTITUTION: The master substrate 7 to which an etching process is completed is passed through a conveyor oven, etc., and the temperature of the substrate and the temperature of a resist-mask-pattern are elevated up to approximately 100~120°C. The mask substrate 7 is placed instantaneously on a target electrode 4 heated previously at 100~120°C of the plasma-ashing device during a time when its temperature drops. The inside of the treating chamber of the ashing device is brought to an oxygen atmosphere at approximately 0.1~0.5Torr pressure, high-frequency power of values such as approximately 13.56MHz 300~500W is applied between the target electrode 4 and an opposite electrode 6, and O₂ plasma is generated between both electrodes. The resist is oxidized by oxygen ions excited by plasma, and gasified and removed, and a photo-mask is completed.

COPYRIGHT: (C)1984, JPO&Japio

[Previous Doc](#) [Next Doc](#) [Go to Doc#](#)

BEST AVAILABLE COPY

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—41835

⑬ Int. Cl.³
H 01 L 21/30

識別記号

府内整理番号
Z 6603—5F

⑭ 公開 昭和59年(1984)3月8日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑮ レジスト剥離方法

川崎市中原区上小田中1015番地
富士通株式会社内

⑯ 特 願 昭57—151526

⑰ 出 願 昭57(1982)8月31日

川崎市中原区上小田中1015番地

⑱ 発明者 丸山浩

⑲ 代理人 弁理士 松岡宏四郎

明細書

1. 発明の名称

レジスト剥離方法

2. 特許請求の範囲

剥離しようとするレジスト膜を有する被処理基板を予備加熱してプラズマ・アッキング装置内に配置し、更に該被処理基板を加熱しながら酸素プラズマにより該被処理基板上のレジスト膜を灰化除去する工程を有することを特徴とするレジスト剥離方法。

3. 発明の詳細な説明

(a) 発明の技術分野

本発明はレジスト剥離方法に係り、特にフォト・マスク製造工程に有利なレジスト剥離方法に関するものである。

(b) 技術の背景

半導体集積回路の製造等に用いられるフォト・マスクは露光・現像によりパターン形成されたレジスト膜を介して、下地の遮光膜をエッチングし遮光膜パターンの形成がなされる。そこで遮光膜

のエッティングが完了した後には上記エッティングのマスクに用いたレジスト膜はマスク基板の表面から除去する必要がある。

上記レジスト膜の除去方法としては、化学薬品や溶剤等を使用する湿式法に比べて、プロセスの簡略化、清浄化、安定化が図れると同時に自動化も容易な乾式法即ち酸素(O₂)プラズマ・アッキング法が多く用いられる。

(c) 従来技術と問題点

第1図は自動化工場に用いられる平行平板型プラズマ・アッキング装置の基本構造を模式的に示したもので、図中1は処理室、2はガス導入口、3は真空排気口、4はターゲット電極、5はヒーター、6は対向電極、7は被処理基板、RFは高周波電源、Gは接地を表わしている。

通常自動化された工程に於ては、上記のような平行平板型のプラズマ・アッキング装置が用いられる。そしてアッキングの速度は温度上昇に伴って指数函数的に上昇するので、従来アッキング速度を早め装置の能力を高めるために、常温の被

BEST AVAILABLE COPY

特開昭59- 41835(2)

処理基板7をターゲット電極4を介してヒータ5により100～120[℃]程度に加熱しながらアッキング処理がなされていた。

しかし被処理基板がマスク基板である場合、その厚さが厚く(5"基板で0.09")、且つ該基板が半導体等に比べて著しく熱伝導率の低いガラスで形成されているために、上記基板加熱によって被処理基板上面の温度がすぐには上昇しない。

そのため従来、フォト・マスク製造工程に於けるレジスト剥離に際してのプラズマ・アッキングはオーバ・アッキング分を含めて5分程度の比較的長時間を要し、アッキング装置の処理能力が低くなるという問題があった。

(d) 発明の目的

本発明はプラズマ・アッキング時間を短縮することが可能なレジスト剥離方法を提供するものであり、その目的とするところはプラズマ・アッキング装置の処理能力を向上せしめるにある。

(e) 発明の構成

即ち本発明はレジスト剥離方法に於て、剥離し

ようとするレジスト膜を有する被処理基板を予備加熱してプラズマ・アッキング装置内に配置し、更に該被処理基板を加熱しながら酸素プラズマにより該被処理基板上のレジスト膜を灰化除去する工程を有することを特徴とする。

(f) 発明の実施例

以下本発明を一実施例について、第1図に示すプラズマ・アッキング装置の基本構造模式図、及び第2図に示すフォト・マスクの製造工程図を用いて詳細に説明する。

本発明のレジスト剥離方法を適用したフォト・マスクの製造工程は第2図に示す工程図のようになる。

即ち先ず例えば遮光膜として900～1000[Å]程度の厚さのクロム膜が主面上に被覆されたガラス基板からなる通常のクロム・ブランク板上に、通常のスピニ・コート法を用いて例えば厚さ1[μm]程度のレジスト膜(ポジ型、ネガ型いずれでも良い)を形成した後、通常通り該レジスト膜のブリ・ベーキング処理を行う。(以上レ

ジスト塗布工程)

次いで通常通り露光・現像を行ないクロム膜上にレジスト・マスク・パターンを形成した後、通常通り該レジスト・マスク・パターンのポスト・ベーキング処理を行う。(以上露光・現像工程)

次いで前記レジスト・マスク・パターンをマスクにして通常通り例えば四塩化炭素(CCl₄)+炭素(0₂)からなるエッティング・ガス中に於て前記クロム膜のリアクティブ・イオン・エッティングを行い、クロム・マスク・パターンを形成する。(以上エッティング工程)

次いでクロム・マスク・パターン上のレジスト・マスク・パターンを剥離するにあたって本発明の方法が適用される。

即ち上記エッティング工程の完了したマスク基板を例えばコンペア炉等を通して、基板温度及びレジスト・マスク・パターンの温度を100～120[℃]程度に昇温せしめる。この際表面温度が150[℃]以上に上昇しないことが望ましい。又加熱雰囲気は空気若しくは炭素が良い。(以上

予備加熱工程)

次いで上記ベーキングを終ったマスク基板を温度が下がらないうちに直ちに第1図に示す通常のプラズマ・アッキング装置の予め100～120[℃]に加熱されたターゲット電極4上に取置する。そしてアッキング装置の処理室内を通常通り0.1～0.5[Torr]程度の圧力の酸素(O₂)雰囲気となし、ターゲット電極4と対向電極6との間に例えば1.356[MHz]・300～500[W]程度の高周波電力を印加し、両面間にO₂プラズマを発生せしめ、該プラズマによって励起された酸素イオン(O⁺)によりレジストを酸化し、ガス化せしめて除去し、フォト・マスクを完成せしめる。(以上レジスト剥離工程)

(g) 発明の効果

以上説明したように本発明の方法に於ては、予備加熱により100～120[℃]程度に昇温せしめたマスク基板が直ちに100～120[℃]に加熱されているアッキング装置のターゲット電極上に取置され、基板及びレジスト・マスク・バ

BEST AVAILABLE COPY

特開昭59- 41835(3)

ターンの温度が上記に近い温度で維持された状態
でO₂ プラズマ・アッシング処理がなされる。

そのため本発明によれば、レジストのアッシ
ング・レートは従来に比べ2倍程度に上昇し、レジ
スト剥離時間はオーバ・アッシング分を含めて2.5
~3分程度に短縮される。

従ってプラズマ・アッシング装置の処理能力は
大幅に向上する。

又前述したようにレジスト剥離時間が短縮され
るので、炭素プラズマの照射により基板に与えら
れる種々のダメージが減少し、フォト・マスクの
製造歩留まりも向上する。

なお本発明の方法は半導体装置の製造工程に於
ても有効である。

4. 図面の簡単な説明

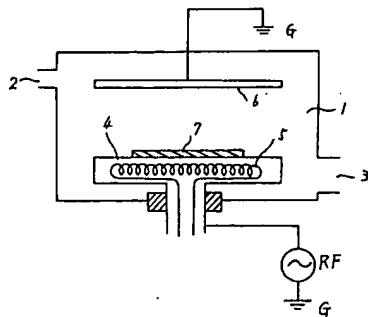
第1図は本発明の一実施例に用いた平行平板型
プラズマ・アッシング装置の基本構造模式図で、
第2図は本発明を適用したフォト・マスク製造工
程に於ける一実施例の工程図である。

図に於て、1は処理室、2はガス導入口、3は

直空排気口、4はターゲット電極、5はヒーター、
6は対向電極、7は被処理基板、RFは高周波電
源、Gは接地を示す。

代理人 弁理士 松岡 宏四郎
松岡宏四郎
12月1日

第1図



第2図

